

Транзистор кремниевый эпитаксиально-планарный структуры *p-n-p* усилительный. Предназначен для применения в селекторах телевизионных каналов с автоматической регулировкой усиления. Выпускается в пластмассовом корпусе с жесткими выводами. Масса транзистора не более 0,1 г. Габаритный чертеж аналогичен KT3126A9.

Электрические параметры

Статистический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кб} = 5$ В, $I_{\Sigma} = 3$ мА	15...150
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кб} = 10$ В, $I_{\Sigma} = 4$ мА, не менее	650 МГц
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте при $U_{кб} = 10$ В, $I_{\Sigma} = 4$ мА, $f = 100$ МГц, не более	5 пс
Коэффициент усиления по мощности на $f = 200$ МГц при $U_{кб} = 10$ В, $I_{\Sigma} = 4$ мА, не менее	14 дБ
Оптимальный ток эмиттера, соответствующий $K_{ур} = K_{ур\ макс}$, при $U_{кб} = 10$ В, $f = 200$ МГц	3...5 мА
Глубина регулирования коэффициента усиления по мощности на $f = 200$ МГц при $U_{кб} = 10$ В, $I_{\Sigma} = 4...9$ мА, не менее	20 дБ
Входное сопротивление в схеме ОБ в режиме малого сигнала при $U_{кб} = 5$ В, $I_{\Sigma} = 1$ мА, $f = 0,05...1$ кГц, не более	34 Ом
Обратный ток коллектора при $U_{кб} = 15$ В, не более	1 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база	35 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{\Sigma} = 10$ кОм	35 В
Постоянное напряжение эмиттер-база	3 В
Постоянный ток коллектора	20 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при $T = -45...+35^{\circ}\text{C}$	110 мВт
Температура <i>p-n</i> перехода	+150 $^{\circ}\text{C}$
Температура окружающей среды	-45...+85 $^{\circ}\text{C}$

Пайку выводов рекомендуется проводить с применением лудящих паст и припоев на расстоянии не менее 0,15 мм от корпуса транзисторов, время пайки не более 4 с, температура пайки не более +265 $^{\circ}\text{C}$.